

論文投稿格式說明：

投稿『2023 第二十一屆微電子技術發展與應用研討會』論文，請必須遵照本論文格式規定進行編排，未依規定格式排版者，本會將以退稿方式處理並不予接受刊登。本研討會是採用摘要簡要內容審查辦理，投稿者請將論文以 WORD、PDF 格式存檔，在論文繳交截稿日期前，依相關程序投稿（詳如研討會網站重要日程公告）。

注意事項：

格式請以 A4 紙張按本研討會規定撰寫，（最優格式第 1 頁為中英文摘要，之後為簡要內容）最少 3 頁至多 5 頁內，請勿插入頁碼，在繳件截止日前將論文電子檔（WORD、PDF 格式）寄至 meta@nkust.edu.tw 研討會信箱投稿。

若有相關問題，敬請連絡：

2023 第二十一屆微電子技術發展與應用研討會

陳玉鴻助理教授、陳惠雯助理

電話：07-3617141 ext 23288、23364

E-mail：meta@nkust.edu.tw

研討會網站：<http://mee.nkust.edu.tw/2023/index.html>

半導體封裝材料耐壽命之研究

Study on the endurance of semiconductor packaging materials

題目(字體大小為14、標楷體、Time New Roman、粗體)

作者A¹ 作者B² 作者C 作者D²

作者(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)

國立高雄科技大學半導體工程系¹ ABCD大學2345工程系² EFGH大學7890系

單位(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)

作者A @xxxx.xxx.xxx 作者B @xxxx.xxx.xxx 作者C @xxxx.xxx.xxx 作者D @xxxx.xxx.xxx

(E-Mail 字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體)

摘要

(字體大小為12、標楷體、Time New Roman)

集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人發表論文演說，就我國微電子技術發展方向與趨勢貢獻心力與智慧，以達到產、官、學合作的政府最高指導原則，並達到發展國內半導體產業，建設台灣為矽島之最終目的。同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

關鍵字：(字體大小為12、標楷體、3-5個)

(若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、標楷體、粗體)

Abstract

(字體大小為12、Time New Roman)

By gathering of the professional scholars and senior administration directors mainly came from the semiconductor manufacturing companies, academic organizations and corresponding official institutions, the topic concerning the tendency of the development of micro-electronic technologies is thoughtfully presented and well discussed. Through the view-points form their elaborate contributions to the micro-electronics, Taiwan as the Silicon Island the government policy, could be ultimately fulfilled. Also, providing direct presentations and dialogues about the development of the micro-electronic technologies in this conference for the students who take interest in the academic field of semiconductor, is to implement the goal of making study serve the practical purpose in the technical and vocational education system.

Keywords: (字體大小為12、Time New Roman、3-5words)

(若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、Time New Roman、粗體)

P.S.

中、英文摘要放置第1頁(共1頁為限)，內文放置第2頁之後。

1. 前言

集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人發表論文演說。

同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2. 原理

集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人發表論文演說。

2.1 理論模擬

同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

2.2 實驗流程

集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人發表論文演說。

同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。

P.S. 排版規式須知:

- (a) 投稿文章用A4(210mm*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。
- (b) 內文中文採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。
- (c) 內文內容使用單行間距，前後段距離0行。
- (d) 中文每段第一行縮排1字元。
- (e) 英文每段第一行縮排5公分。
- (f) 標題與子標題須使用粗體，標題順序為1., 2.,...等等。
- (g) 子標題順序為 1.1，本研討會規定至第二層止。
- (h) 第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體

為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。

- (i) 標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。
- (j) 所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -\nabla p + \nu \Delta v + f(x, t) \quad (1)$$



圖1 流程圖

表1 統計表內容

P.S. 圖表及照片排版規式須知:

- (a) 所有圖表及照片必需附有編號。
- (b) 各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題及說明左右對齊，不用縮排。
- (c) 各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。

P.S. 參考文獻規式須知:

標題字體為10、標楷體、Times New Roman、粗體，參考文獻編號採用[1]、[2]、...，依文中出現順序編列，所列參考文獻必須完整、正確。格式如範例所示:

- [1] Wang, A. B. and Lin, C. D. (2011), "Title of a Paper Published in a Journal," Journal of Power Engineering, 32(1), 101-123.

- [2] 陳大同、王志明，2009，台灣風力發電之效能評估，電力工程學報，23(2)，212-225。
- [3] 蕭潔恒，2010，高鐵列車技術百科，共和媒體出版，74-76。
- [4] 李錫軍，2016，三維拍翼流場模擬之初探，淡江大學機械與機電工程學系碩士論文，58-62。
- [5] 700T 台灣高速鐵路電車模型製作 (<https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=368&t=4338865>)